



① Veröffentlichungsnummer: 0 405 304 A3

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG (12)

(21) Anmeldenummer: 90111587.3

2 Anmeldetag: 19.06.90

(51) Int. Cl.⁵: **H01C 7/00**, H01C 17/12, H01C 17/08

(30) Priorität: 29.06.89 DE 3921431

43 Veröffentlichungstag der Anmeldung: 02.01.91 Patentblatt 91/01

84) Benannte Vertragsstaaten: DE FR GB NL

Weröffentlichungstag des später veröffentlichten Recherchenberichts: 03.06.92 Patentblatt 92/23 (71) Anmelder: SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2 W-8000 München 2(DE)

(72) Erfinder: Hoheisel, Martin, Dr. Thereses-Giehse-Allee 87 W-8000 München 83(DE) Erfinder: Mrotzek, Christine Karwendelstrasse 166 W-8017 Ebersberg(DE) Erfinder: Müller, Werner Zeppelinstrasse 5 W-8025 Unterhaching(DE)

- (54) Dünnschichtwiderstände mit Flächenwiderstandswerten im Bereich zwischen 1M-Ohm und mehreren G-Ohm und Verfahren zu ihrer Herstellung.
- 57) Aus einem transparenten, leitfähigen Oxid, insbesondere aus Indium-Zinn-Oxid (= ITO) bestehende Dünnschichtwiderstände weisen Flächenwiderstandswerte zwischen 1 M-Ohm und mehreren G-Ohm auf, wenn ihre Herstellung durch Sputtern oder Aufdampfen in einer Atmosphäre mit einem erhöh-Sauerstoffpartialdruck erfolgt. Es können Dünnfilm-Widerstände aus ITO-Schichten im Bereich von 8 M-Ohm und 40 G-Ohm realisiert werden, die für integrierte Schaltungen in der Großflächenelektronik Anwendung finden.

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

90 11 1587

	EINSCHLÄGIGE	DOKUMENTE		
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments der maßgeblicher	mit Angabe, soweit erforderlich, Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.5)
•	THIN SOLID FILMS. Bd. 162, Nr. 1, August 19 Seiten 119 - 127; DUTTA ET AL.: 'Variations electrical properties of indium tin oxide films with parameters' * Seite 119, Absatz 1 * * Seite 123; Abbildung 7	s in structural and magnetron-sputtered Ith deposition	1-3,5	H01C7/00 H01C17/12 H01C17/08
A	FR-A-2 261 601 (THOMSON-C * Seite 2, Zeile 2 - Zeil		1-3,5	
A	THIN SOLID FILMS. Bd. 128, Nr. 3/4, Juni 19 Seiten 231 - 239; BHATTACHARYYA ET AL.: 'Pr characterization of indiu produced by the D.C sputt * Seite 237, Absatz 3.2 *	reparation and im tin oxide films ering technique'	1-3	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.5 H01C C23C H01L
Der vo	rliegende Recherchenbericht wurde f	ür alle Patentansprüche erstellt Abschlußdatum der Recherche		Prüfer
	DEN HAAG	31 MAERZ 1992	MES	
X : von Y : von	KATEGORIE DER GENANNTEN DOI besonderer Bedeutung allein betrachtet besonderer Bedeutung in Verbindung mi eren Veröffentlichung derselben Kategori	E : älteres Patentd nach dem Ann it einer D : in der Anweld	zugrunde liegende ? lokument, das jedoc leidedatum veröffen ung angeführtes Do inden angeführtes !	tlicht worden ist okument

- A: technologischer Hintergrund
 O: nichtschriftliche Offenbarung
 P: Zwischenliteratur

å : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument